背光模組及背光源之設計與模擬

鄭翔遠、韓斌:黃俊達

E-mail: 9314945@mail.dyu.edu.tw

摘要

本研究主要利用光學模擬軟體,模擬背光模組及背光源,分為2個方向,1.背光板入光側V型溝槽結構之光學的模擬與最佳化,2.微結構陣列應用於LED內部結構的模擬與最佳化。 1.背光板入光側V型溝槽結構之光學的模擬與最佳化,去探討目前液晶面板所使用的導光板入光側之結構,並了解光源耦合效率問題,使LED的光源出射後進入導光板的光場變大,並且檢視觀察面的光場分佈是否均勻。在此論文中我們提出使用V型溝槽作為導光板最前端的結構,以改善光源之分佈狀況,並以V型溝槽刻痕為70°、80°、90°、100°、110°和120°等角度及斜平比為1:0至1:5來進行模擬分析,以期得到最佳化的趨勢,進而完成光源的最佳分佈狀況。 2.模擬微結構陣列應用於LED內部結構的最佳化,發光二極體(LED)有著眾多的優點,但由於LED晶體內的外部量子效應無法突破,使其發光效率仍有改善空間。本篇論文主要在於探討藍寶石基板上加入微結構陣列對於提升LED發光元件外部量子效率的效果,以及其對於LED發光元件出光效率的影響,微結構陣列以圓錐體為模組,改變圓錐體的角度 y由60°、75°、90°及高度為0.5µm至2µm來進行模擬。模擬結果顯示,於藍寶石基板上做出微結構陣列,並選擇適當的角度及高度,可有效提升LED發光晶體的出光效率。

關鍵詞:光學模擬;V型溝槽;斜平比;微結構;藍寶石基板

目錄

| 封面內頁 簽名頁 授權書 | iii | 中文摘要 |
|------------------------|-----------------|---------------------|
| iv 英文摘要 | | v 誌謝 |
| vii 目錄 | | viii 圖目錄 |
| x 第 | 第一章 緒論 | 1 1.1 研究動 |
| 機11 | .2研究方法與論文結構 | 2 第二章 光學基本 |
| 理論 | 4 2.1基本概念 | 4 2.2 平面界面的反 |
| 射和折射5 第三章 | 背光板入光側V型溝槽結構之光學 | 的模擬與最佳化11 3.1前言與簡介… |
| 11 3.2 LEI | D光源及導光板結構說明 | 14 3.3 第一組模組模擬步驟 |
| 15 3.3.1 實驗結果 | 具與討論 | 17 3.3.2 第一模組結論 |
| 23 3.4 第二組模組LED光源及導光板 | 反結構說明24 3.5 第二組 | 模組模擬步驟 |
| 24 3.5.1 實驗結果與討論 | 25 3.5.2 第二模組結論 | 扁31 第 |
| 四章 微結構陣列應用於LED內部結構的模擬與 | 與最佳化33 4.1前言 | |
| 33 4.2模擬概述 | 35 4.3模擬設計和設定 | Ē37 |
| 4.4模擬結果與討論 | 39 第五章 總結論 | |
| 46 參考文獻 | 48 | |

參考文獻

- [1] Yoshitaka Koyama, "Ray-Tracing Simulation in LCD Development ", May 18(2001).
- [2] C. S. Lin, W. Z. Wu, Y. L. Lay, M. W. chang, "A digital image-based measurement system for a LCD backlight module", Optics and Laser Technology 33,495-505(2001).
- [3] 葉金娟譯,"液晶的背光及其周邊技術-使液晶板高效率化和高輝度的導光板",電子月刊第三卷第一期115頁1997年 [4] 鮑友南、潘奕凱、姚柏宏、林建憲,"TV用液晶顯示器之背光模組技術",微機電技術專利,機械工業雜誌245期158頁2003年。
- [5] 施至柔 , "背光模組光學模擬技術", 交通大學光電工程研究所碩士論文, 民國87年。
- [6] 蘇紹安, "非印刷式背光模組光學模擬分析",中華大學電機研究所碩士論文,民國90 [7] ENDEL UIGA, "optoelectronics", Chapter 1-3, Prentice-Hall (1995).
- [8] 董德國、陳萬清 譯, " 光纖通訊 ",pp.65~97,台灣東華,民89 [9] Eugene Hecht, " Optics ",4th Edition, Chapter4、5、8,Addison Wesley 2002
- [10] 許招庸 編譯 , " 現代照明實務 " , pp.33-3~3-12 , 全華 , 民87 [11] 蘇怡玲、鍾明昌、魏茂國、林宏? , " 微透鏡陣列應用於有機元件之探計 " , 2004台灣顯示科技研討會第266頁。

[12] Y. P. Hsu, S. J. Chang, Y. K. Su, J. k. Sheu, C. T. LEE, T. C. Wen, L. W. Wu, C. H. Kuo, C. S. Chang, S. C. Shei, "Lateral epitaxial patterned sapphire InGaNGaN MQW LEDs, Journal of Crystal Growth 261 (2004) 466-470 [13] 劉彥泓,"奈米級電漿粗化在光電元件之應用",大葉大學電機工程研究所碩士論文、民國90